df Electric



RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES



03

gR
CIL
fusibles



04

aR
CIL
fusibles



05

gS
NH
fusibles



07

aR
NH
fusibles

RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL gR CILINDRICOS fusibles

Los fusibles RAPIDPLUS gR protegen en todo el rango de sobrecorrientes, tanto contra sobrecargas como contra cortocircuitos, con lo que además de proteger a los dispositivos semiconductores, también se protege a los cables y el resto de aparellaje de la instalación. Las aplicaciones típicas comprenden la protección de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificadores de potencia, SAI's, convertidores, variadores de velocidad de motores (AC y DC), arrancadores suaves, relés de estado sólido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en general cualquier aplicación donde se precise proteger componentes semiconductores. Están certificados según norma UL248. UL File Nr. E477155.

10x38

U **690V AC**

PODER DE CORTE **200kA** 30kA @440V DC

NORMAS

In (A)	REFERENCIA SIN PERCUTOR	REFERENCIA CON PERCUTOR	EMBALAJE Uni /CAJA
1	492000		10/100
2	492001		10/100
3	492002		10/100
4	492003		10/100
6	492004		10/100
8	492005		10/100
10	492006		10/100
12	492007		10/100
16	492008		10/100
20	492009		10/100
25	492010		10/100
32	492011		10/100



14x51

U **690V AC**

PODER DE CORTE **200kA** 30kA @440V DC

NORMAS

In (A)	REFERENCIA SIN PERCUTOR	REFERENCIA CON PERCUTOR	EMBALAJE Uni /CAJA
4	492014		10/50
6	492015		10/50
8	492016	492116	10/50
10	492017	492117	10/50
12	492018	492118	10/50
16	492019	492119	10/50
20	492020	492120	10/50
25	492021	492121	10/50
32	492022	492122	10/50
40	492023	492123	10/50
50	492024	492124	10/50



22x58

U **690V AC**

PODER DE CORTE **200kA** 30kA @440V DC

NORMAS

In (A)	REFERENCIA SIN PERCUTOR	REFERENCIA CON PERCUTOR	EMBALAJE Uni /CAJA
20	492033	492133	10/50
25	492034	492134	10/50
32	492035	492135	10/50
40	492036	492136	10/50
50	492037	492137	10/50
63	492038	492138	10/50
80	492039	492139	10/50
100	492040	492140	10/50



NORMAS

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-6
UL 248-1
UL 248-13

DIMENSIONES

PAG 9
PAG 11
PAG 13

CARACTERISTICAS t-I | LIMITACION

PAG 10
PAG 12
PAG 14

USO EN BASES PORTAFUSIBLES PMX

PAG 37

RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL aR CILINDRICOS fusibles

Los fusibles RAPIDPLUS aR protegen contra los cortocircuitos y están diseñados y construidos para tener unos valores muy reducidos de I^2t que garantizan una optima protección de los semiconductores. Presentan una gran resistencia al envejecimiento ante variaciones cíclicas de corriente. Las aplicaciones típicas comprenden la protección de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificadores de potencia, SAI's, convertidores, variadores de velocidad de motores (AC y DC), arrancadores suaves, relés de estado sólido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en general cualquier aplicación donde se precise proteger componentes semiconductores. Están certificados según norma UL248. UL File Nr. E477155.

10x38

U **690V AC**

PODER DE CORTE **200kA** 30kA @700V DC

NORMAS

In (A)	REFERENCIA SIN PERCUTOR	REFERENCIA CON PERCUTOR	EMBALAJE Uni /CAJA
1	491105		10/100
2	491107		10/100
3	491100		10/100
4	491113		10/100
6	491115		10/100
8	491120		10/100
10	491125		10/100
12	491130		10/100
16	491135		10/100
20	491140		10/100
25	491145		10/100
32	491155		10/100



14x51

U **690V AC**

PODER DE CORTE **200kA** 30kA @700V DC

NORMAS

In (A)	REFERENCIA SIN PERCUTOR	REFERENCIA CON PERCUTOR	EMBALAJE Uni /CAJA
4	491215		10/50
6	491225		10/50
8	491230	491730	10/50
10	491235	491735	10/50
12	491237	491737	10/50
16	491241	491741	10/50
20	491245	491745	10/50
25	491250	491750	10/50
32	491260	491760	10/50
40	491265	491765	10/50
50	491270	491770	10/50



22x58

U **690V AC**

PODER DE CORTE **200kA** 30kA @700V DC

NORMAS

In (A)	REFERENCIA SIN PERCUTOR	REFERENCIA CON PERCUTOR	EMBALAJE Uni /CAJA
20	491300	491800	10/50
25	491305	491805	10/50
32	491310	491810	10/50
40	491315	491815	10/50
50	491320	491820	10/50
63	491325	491825	10/50
80	491330	491830	10/50
100	491335	491835	10/50



NORMAS

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-6
UL 248-1
UL 248-13

DIMENSIONES

PAG 15
PAG 17
PAG 19

CARACTERISTICAS t-I | LIMITACION

PAG 16
PAG 18
PAG 20

USO EN BASES PORTAFUSIBLES PMX

PAG 37

RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH gS NH fusibles

Los fusibles RAPIDPLUS NH gS protegen en todo el rango de sobrecorrientes, tanto contra sobrecargas como contra cortocircuitos, con lo que además de proteger a los dispositivos semiconductores, también se protege a los cables y el resto de aparellaje de la instalación. Están optimizados para mantener unos valores bajos de potencia disipada, lo que permite que estos cartuchos fusibles sean montados en cualquier base, seccionador o interruptor con fusibles. Las aplicaciones típicas comprenden la protección de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificadores de potencia, SAI's, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores suaves, relés de estado sólido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en general cualquier aplicación donde se precise proteger componentes semiconductores de potencia.

NH000

U **690V AC**

PODER DE CORTE **100kA** 30kA @440V DC

I_n (A)	REFERENCIA	EMBALAJE Uni /CAJA
20	**371025**	3/90
25	**371030**	3/90
32	**371035**	3/90
40	**371045**	3/90
50	**371050**	3/90
63	**371055**	3/90
80	**371060**	3/90
100	**371065**	3/90



NH00

U **690V AC**

PODER DE CORTE **100kA** 30kA @440V DC

125	**371070**	3/60
160	**371075**	3/60



NH1

U **690V AC**

PODER DE CORTE **100kA** 30kA @550V DC

125	**371250**	3/30
160	**371255**	3/30
200	**371260**	3/30
250	**371270**	3/30
280	**371273**	3/30



NORMAS

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4

DIMENSIONES

PAG 21 NH000 NH00
PAG 23 NH1

CARACTERISTICAS t-I | LIMITACION

PAG 22 NH000 NH00
PAG 24 NH1

RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH gS NH fusibles

Los fusibles RAPIDPLUS NH gS protegen en todo el rango de sobrecorrientes, tanto contra sobrecargas como contra cortocircuitos, con lo que además de proteger a los dispositivos semiconductores, también se protege a los cables y el resto de aparellaje de la instalación. Están optimizados para mantener unos valores bajos de potencia disipada, lo que permite que estos cartuchos fusibles sean montados en cualquier base, seccionador o interruptor con fusibles. Las aplicaciones típicas comprenden la protección de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificadores de potencia, SAI's, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores suaves, relés de estado sólido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en general cualquier aplicación donde se precise proteger componentes semiconductores de potencia.

NH2

U **690V AC**

PODER DE CORTE **100kA** **30kA @550V DC**

250	**371360**	3/18
315	**371370**	3/18
355	**371375**	3/18
400	**371380**	3/18
450	**371387**	3/18



NH3

U **690V AC**

PODER DE CORTE **100kA** **30kA @550V DC**

355	**371450**	1/15
400	**371455**	1/15
450	**371463**	1/15
500	**371465**	1/15
630	**371470**	1/15



NORMAS

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4

DIMENSIONES

PAG 25 NH2
PAG 27 NH3

CARACTERISTICAS t-I | LIMITACION

PAG 26 NH2
PAG 28 NH3

RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH aR NH fusibles

Los fusibles RAPIDPLUS NH aR tienen unos valores de I^2t muy bajos gracias al diseño de sus elementos de fusión, que están realizados en plata pura. La arena está solidificada, lo que proporciona un excelente control del arco eléctrico, un alto poder de corte y un buen comportamiento ante el trabajo cíclico. Estos cartuchos fusibles poseen un indicador de fusión que puede emplearse como indicador visual o para actuar un microrruptor que se coloca directamente sobre el fusible. Las aplicaciones típicas comprenden la protección de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificadores de potencia, SAI's, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores suaves, relés de estado sólido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en general cualquier aplicación donde se precise proteger componentes semiconductores de potencia.

NH000

U **690V AC**

PODER DE CORTE **120kA** **30kA @440V DC**

In (A)	REFERENCIA	EMBALAJE Uni /CAJA
16	**365020**	3/90
20	**365025**	3/90
25	**365030**	3/90
32	**365035**	3/90
40	**365045**	3/90
50	**365050**	3/90
63	**365055**	3/90
80	**365060**	3/90
100	**365065**	3/90
125	**365070**	3/90
160	**365075**	3/90
200	**365080**	3/90
250	**365085**	3/90



NH1

U **690V AC**

PODER DE CORTE **120kA** **30kA @550V DC**

In (A)	REFERENCIA	EMBALAJE Uni /CAJA
40	**365225**	3/30
50	**365230**	3/30
63	**365235**	3/30
80	**365240**	3/30
100	**365245**	3/30
125	**365250**	3/30
160	**365255**	3/30
200	**365260**	3/30
250	**365270**	3/30
315	**365280**	3/30
350	**365282**	3/30
400	**365290**	3/30



NORMAS

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4

DIMENSIONES

PAG 29 (NH000)
PAG 31 (NH1)

CARACTERISTICAS t-I | LIMITACION

PAG 30 (NH000)
PAG 32 (NH1)

COEFICIENTE DE CORRECCION C_L

PAG 38

RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH aR NH fusibles

Los fusibles RAPIDPLUS NH aR tienen unos valores de I^2t muy bajos gracias al diseño de sus elementos de fusión, que están realizados en plata pura. La arena está solidificada, lo que proporciona un excelente control del arco eléctrico, un alto poder de corte y un buen comportamiento ante el trabajo cíclico. Estos cartuchos fusibles poseen un indicador de fusión que puede emplearse como indicador visual o para actuar un microrruptor que se coloca directamente sobre el fusible. Las aplicaciones típicas comprenden la protección de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificadores de potencia, SAI's, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores suaves, relés de estado sólido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en general cualquier aplicación donde se precise proteger componentes semiconductores de potencia.

NH2

U **690V AC**

PODER DE CORTE **120kA** **30kA @550V DC**

200	**365350**	3/18
250	**365360**	3/18
315	**365370**	3/18
350	**365372**	3/18
400	**365380**	3/18
450	**365387**	3/18
500	**365390**	3/18
550	**365392**	3/18
630	**365395**	3/18
700	**365397**	3/18



NH3

U **690V AC**

PODER DE CORTE **120kA** **30kA @550V DC**

500	**365465**	1/15
550	**365467**	1/15
630	**365470**	1/15
700	**365472**	1/15
800	**365475**	1/15
900	**365480**	1/15
1000	**365485**	1/15



NORMAS

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4

DIMENSIONES

PAG 33 NH2
PAG 35 NH3

CARACTERISTICAS t-I | LIMITACION

PAG 34 NH2
PAG 36 NH3

COEFICIENTE DE CORRECCION C_L

PAG 38

RAPIDPLUS

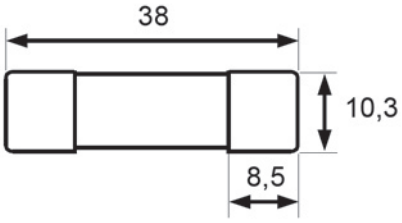
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 10x38 | gR CILINDRICOS fusibles

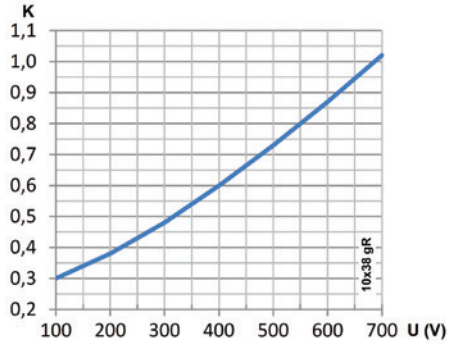
TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	1A...32A	200kA (690V AC)
		30kA (440V DC)



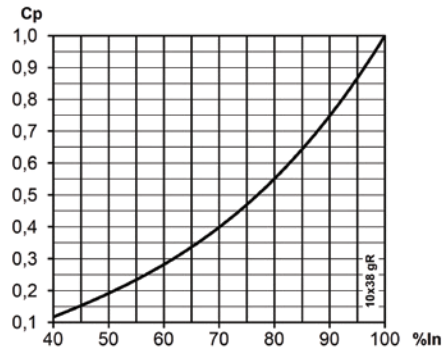
DIMENSIONES



COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



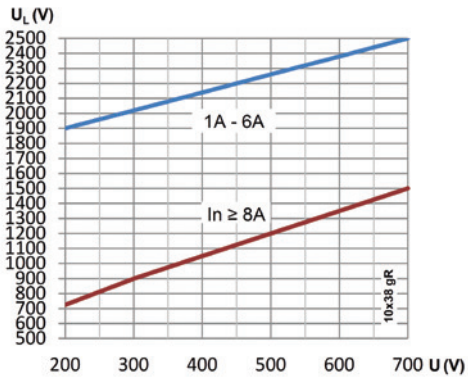
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · I_n	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
1	0,20	1,2	0,45	0,75
2	0,80	2,6	0,75	1,40
3	2,5	8,0	0,95	1,70
4	5,6	17	1,13	2,05
6	16,0	48	1,56	3,00
8	4,3	38	0,97	1,68
10	6,6	59	1,20	2,09
12	9,6	84	1,69	2,99
16	17,0	150	2,31	4,27
20	23,5	200	2,86	5,35
25	60,2	512	2,94	5,52
32	94,0	800	3,82	7,43

TENSION DE ARCO (U_L)

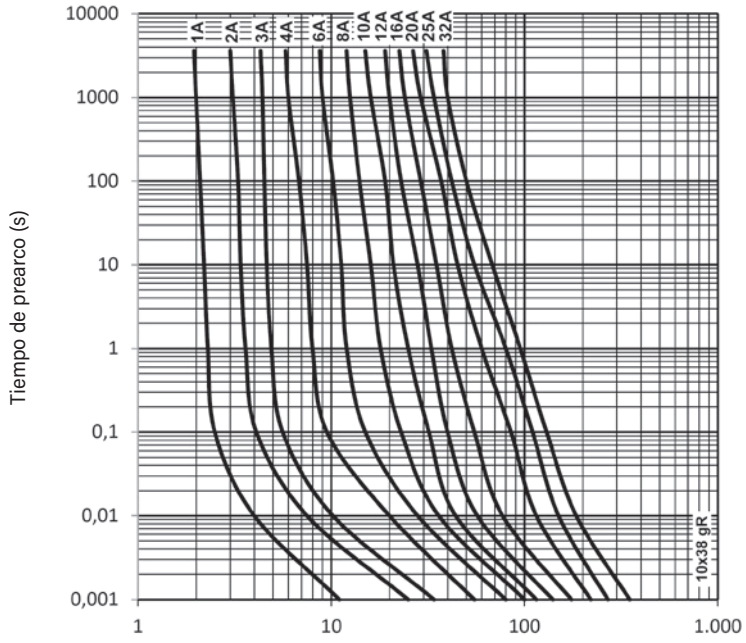


RAPIDPLUS

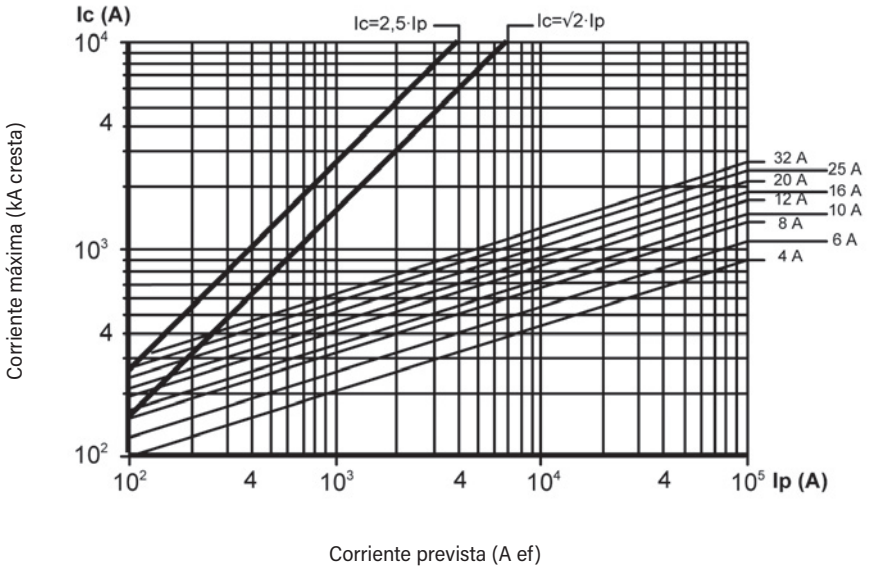
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 10x38 **gR** CILINDRICOS fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

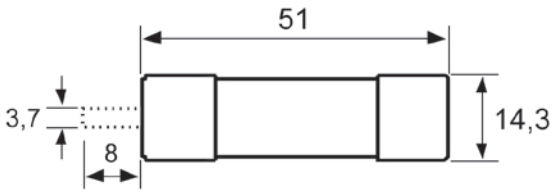
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 14x51 **gR** CILINDRICOS fusibles

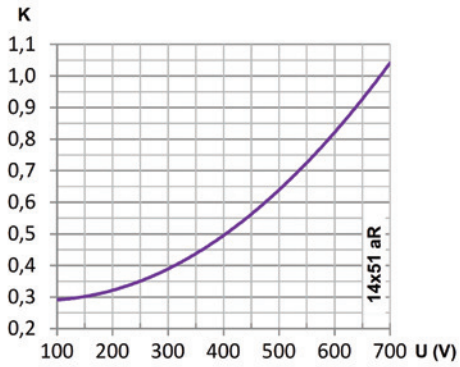
TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	4A...50A	200kA (690V AC)
		30kA (700V DC)



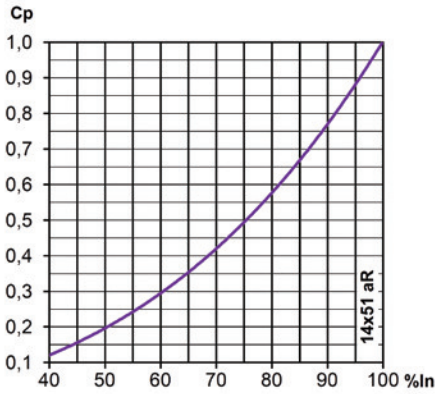
DIMENSIONES



COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



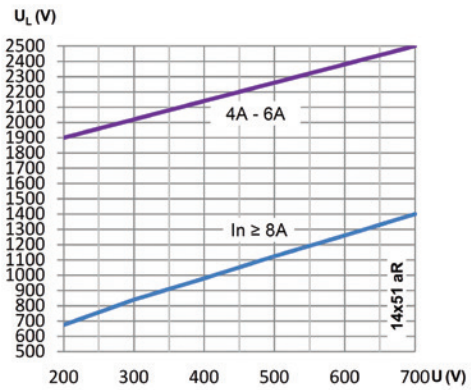
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · I_n	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
4	5,6	17	1,56	2,94
6	16,0	48	2,25	4,20
8	3,8	30	1,18	2,00
10	5,9	47	1,41	2,52
12	8,4	68	1,95	3,54
16	15	120	2,67	4,83
20	27	170	2,91	5,40
25	53	333	3,38	6,00
32	108	679	3,72	6,93
40	211	1331	4,13	7,52
50	350	2200	5,36	9,80

TENSION DE ARCO (U_L)

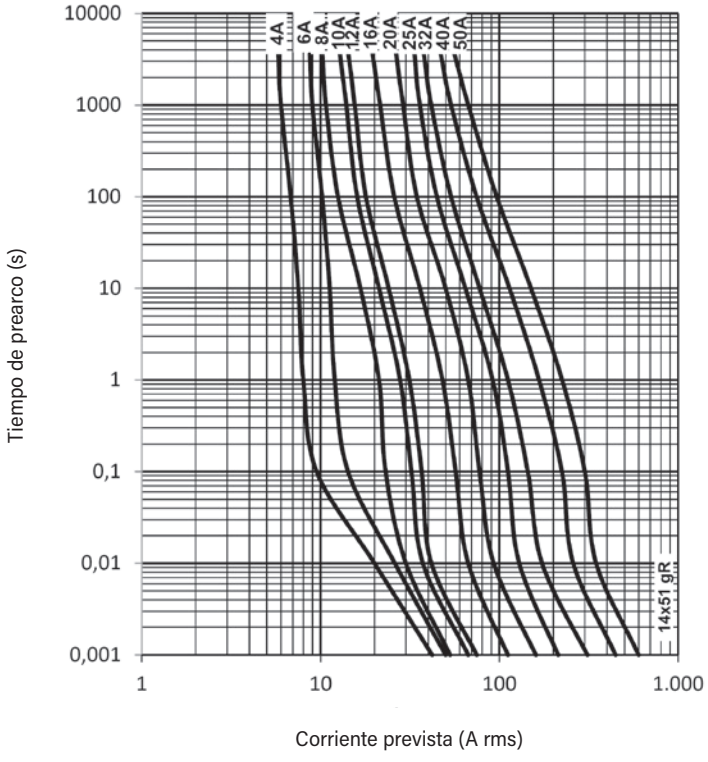


RAPIDPLUS

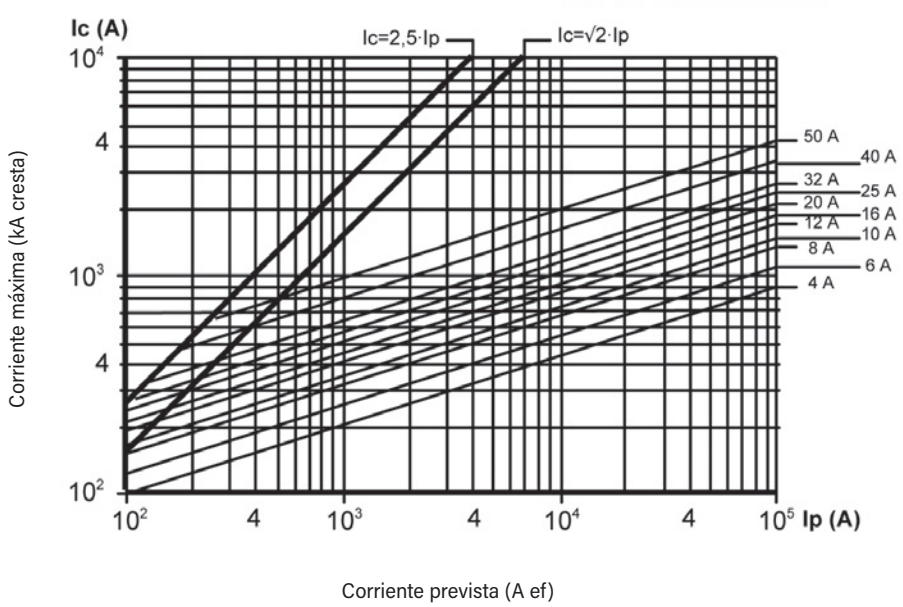
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 14x51 **gR** CILINDRICOS fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

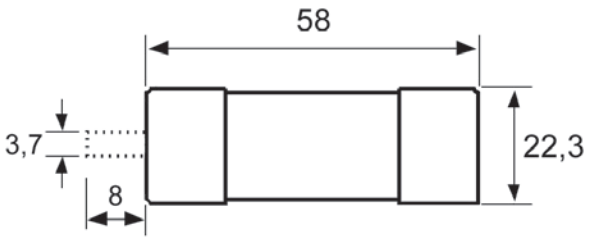
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 22x58 | gR CILINDRICOS fusibles

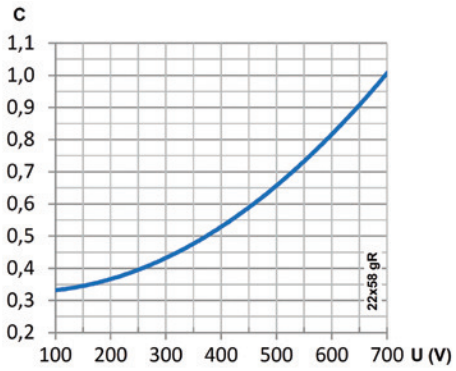
TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	20A...100A	200kA (690V AC)
		30kA (700V DC)



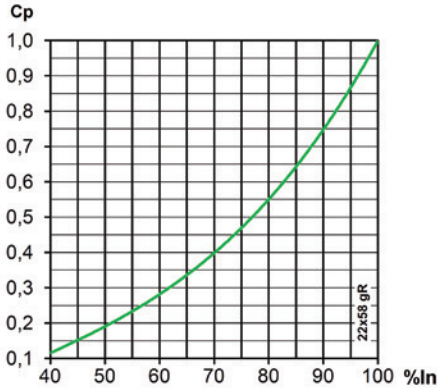
DIMENSIONES



COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



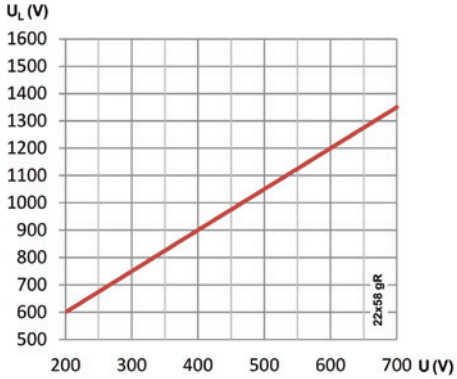
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA $0.8 \cdot I_n$	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
20	19	103	3,00	5,25
25	34	182	3,40	5,85
32	60	324	4,50	8,20
40	94	506	6,10	10,80
50	158	856	7,50	13,70
63	375	2025	7,70	14,00
80	634	3422	9,65	17,60
100	1500	8100	10,30	18,00

TENSION DE ARCO (U_L)

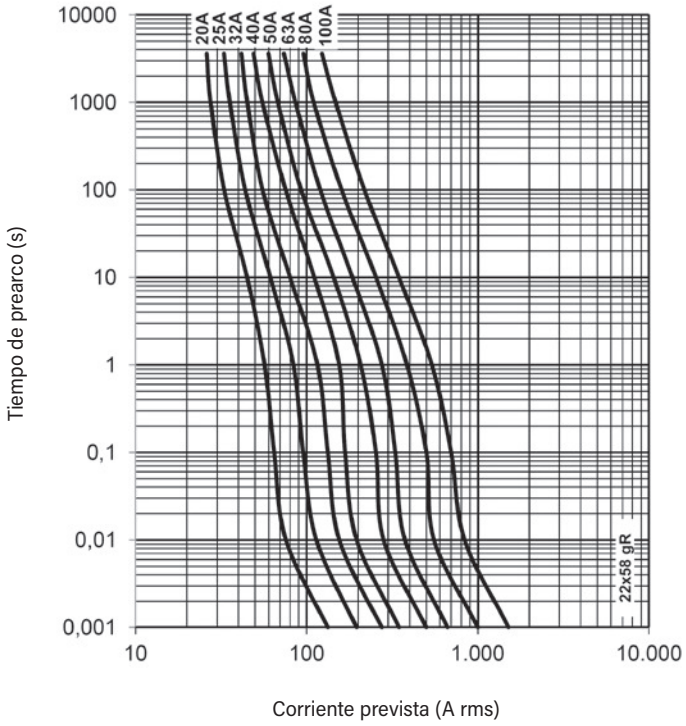


RAPIDPLUS

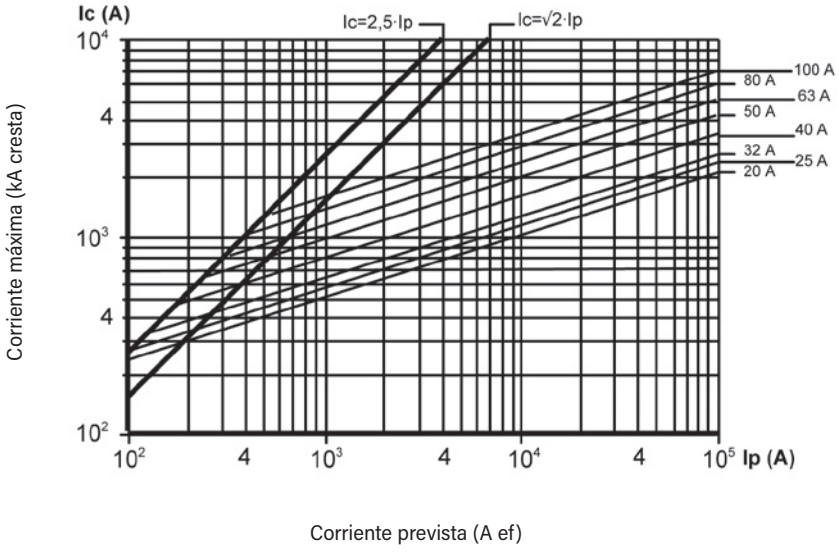
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 22x58 **gR** CILINDRICOS fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

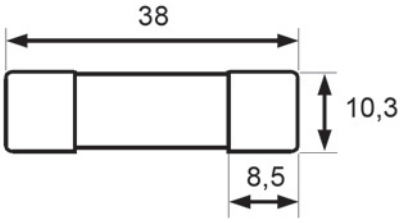
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 10x38 **aR**
CILINDRICOS
fusibles

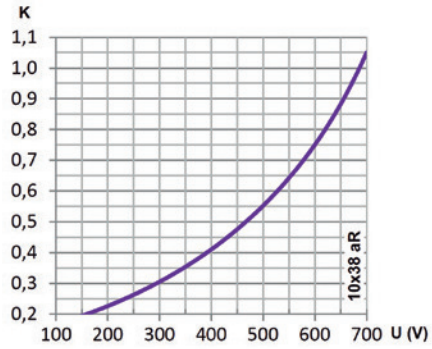
TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	1A...32A	200kA (690V AC) 30kA (700V DC)



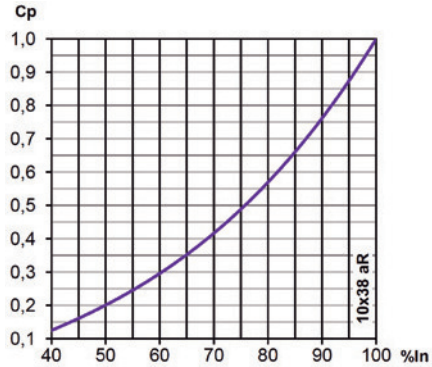
DIMENSIONES



COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)

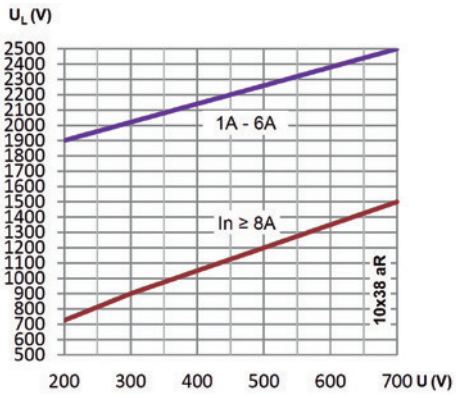


POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · I_n	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
1*	0,20	1,2	0,45	0,75
2	0,80	2,6	0,75	1,40
3	2,5	8,0	0,95	1,70
4	4,9	10	0,97	1,69
6	14,0	28	1,4	2,46
8	3,0	24	0,91	1,52
10	4,7	38	1,23	2,07
12	6,8	54	1,53	2,62
16	12,0	96	2,11	3,72
20	18,8	150	2,57	4,50
25	48,0	384	2,60	4,55
32	75,0	600	3,65	6,65

* sin certificado UL

TENSION DE ARCO (U_L)

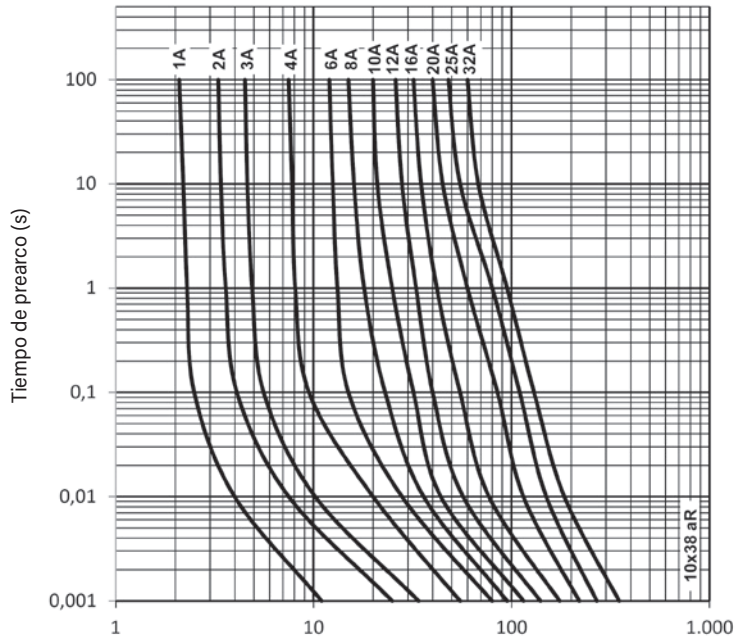


RAPIDPLUS

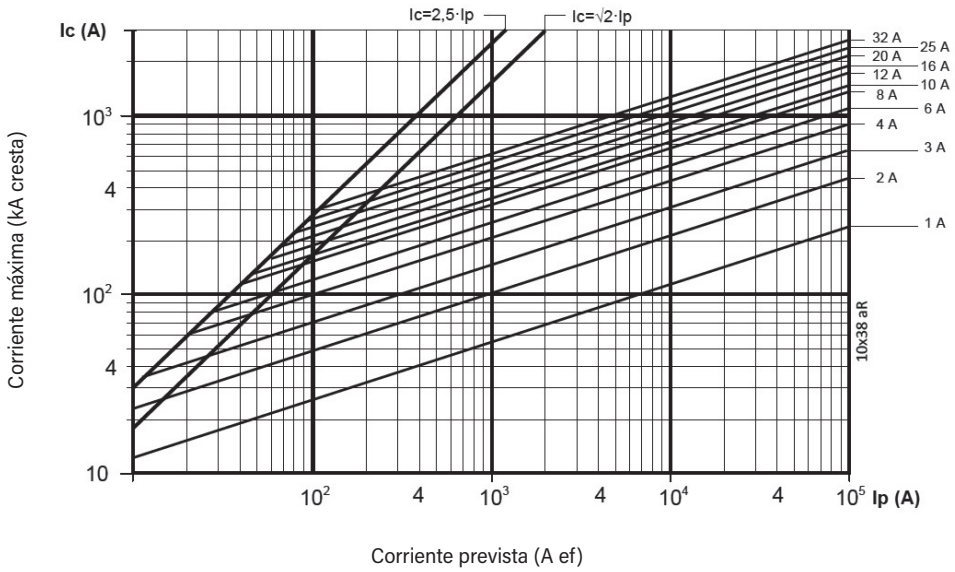
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 10x38 aR CILINDRICOS fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

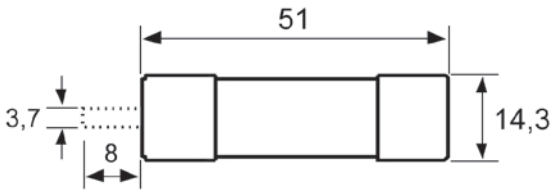
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 14x51 **aR** CILINDRICOS fusibles

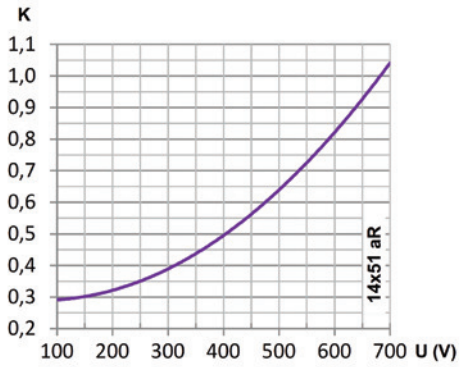
TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	4A...50A	200kA (690V AC)
		30kA (700V DC)



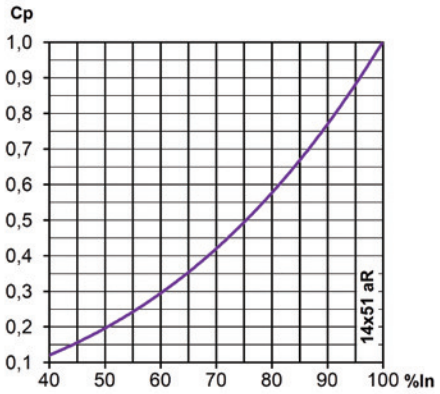
DIMENSIONES



COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



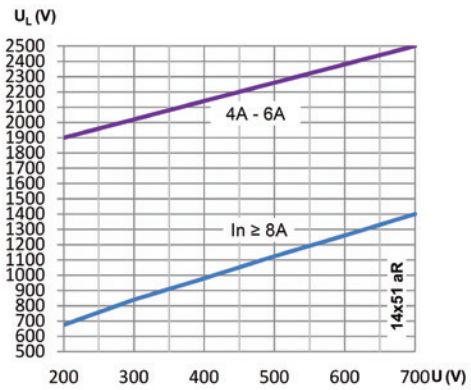
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · I_n	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
4	5,6	14	1,32	2,28
6	16,0	40	1,80	3,18
8	4,1	23	1,01	1,69
10	6,3	37	1,39	2,36
12	9,1	53	1,63	2,78
16	12,4	72	2,43	4,16
20	20,6	119	3,04	5,43
25	36,6	211	3,75	6,11
32	82,3	475	3,92	7,17
40	146,3	844	4,52	8,15
50	260,0	1500	5,60	10,6

TENSION DE ARCO (U_L)

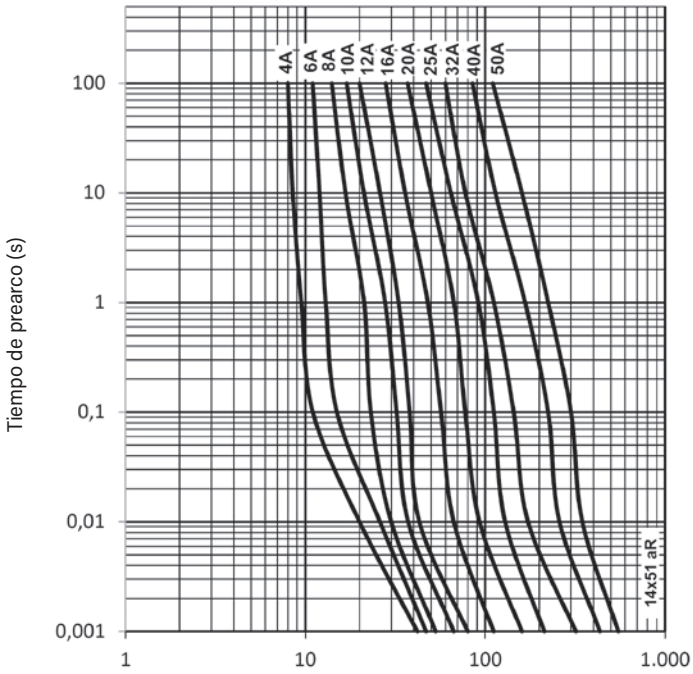


RAPIDPLUS

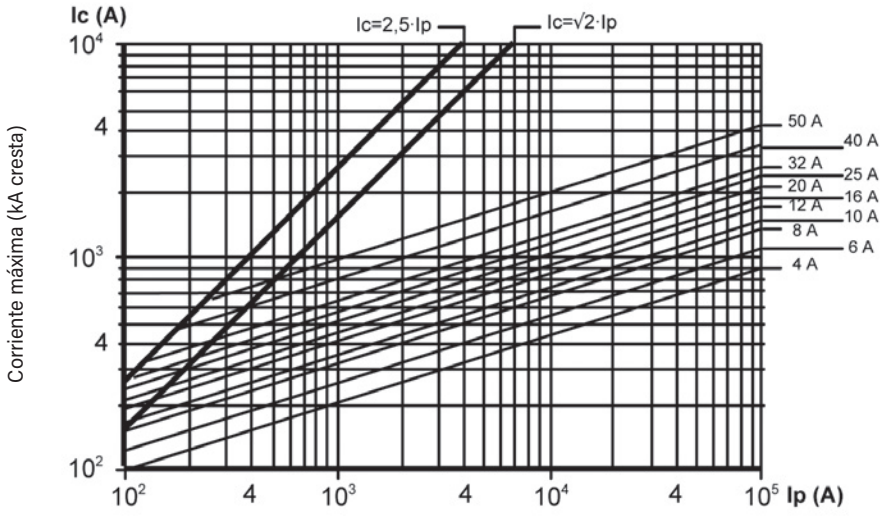
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 14x51 aR CILINDRICOS fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

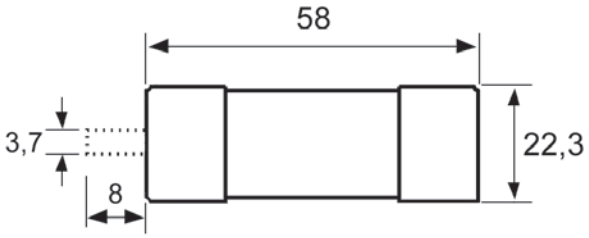
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 22x58 **aR** CILINDRICOS fusibles

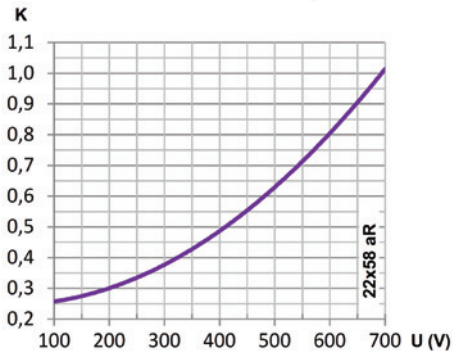
TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	20A...100A	200kA (690V AC)
		30kA (700V DC)



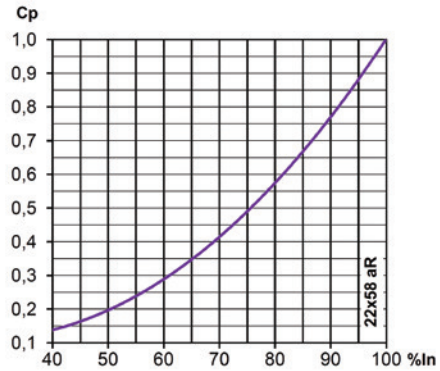
DIMENSIONES



COEFICIENTE DE CORRECCION I^2t (K)



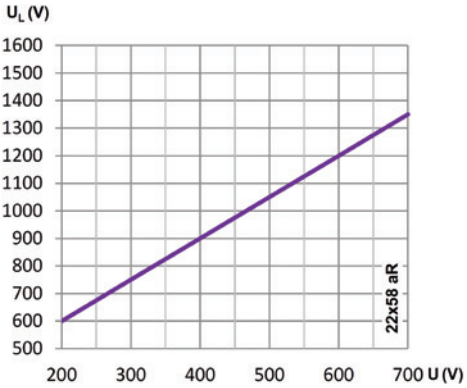
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA $0.8 \cdot I_n$	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
20	19	103	3,00	5,25
25	34	182	3,40	5,85
32	60	324	4,50	8,20
40	94	506	6,10	10,80
50	158	856	7,50	13,70
63	375	2025	7,70	14,00
80	634	3422	9,65	17,60
100	1500	8100	10,30	18,00

TENSION DE ARCO (U_L)

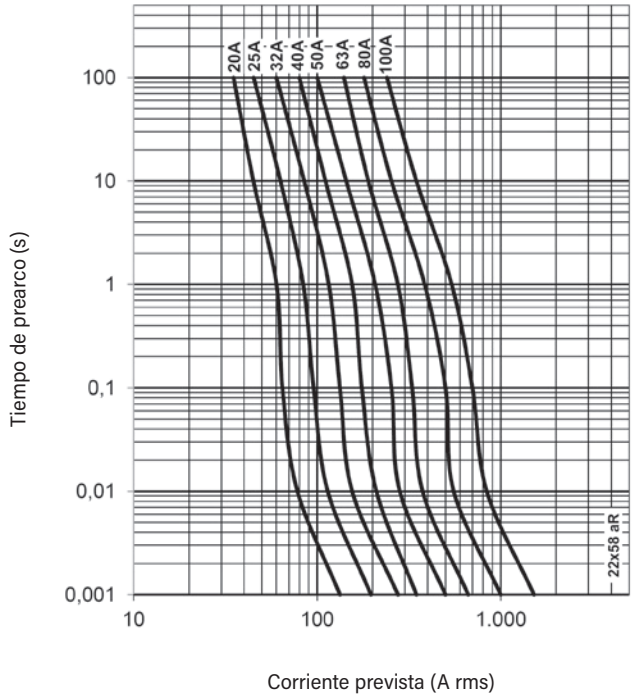


RAPIDPLUS

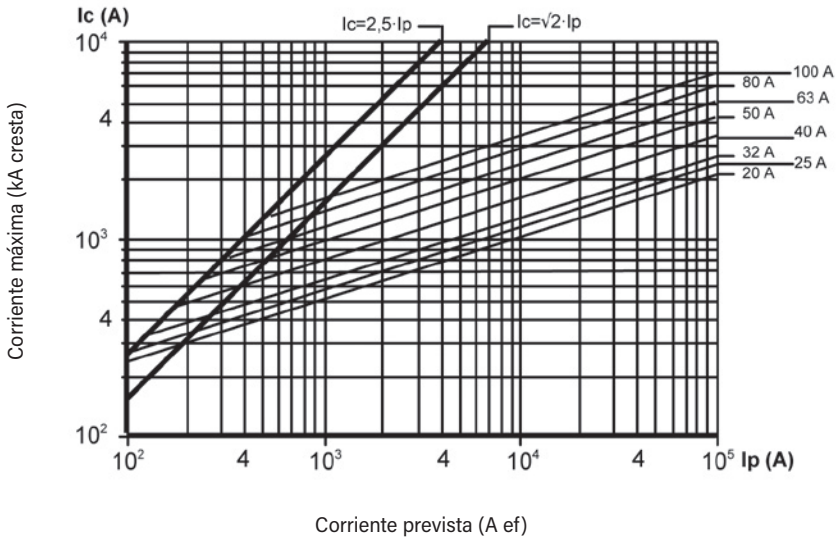
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL 22x58 aR CILINDRICOS fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

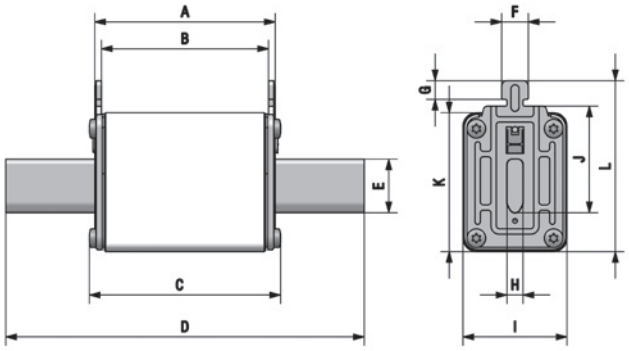
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH000 NH00 **gS** NH fusibles



TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	20A...160A	100kA (690V AC)
		30kA (440V DC)

DIMENSIONES



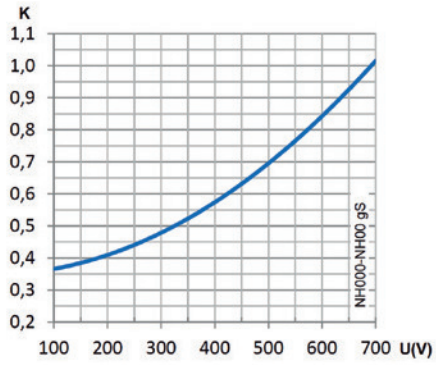
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NH000	49	45	52	78,5	15	10	9,5	6	21	35	40	53
NH00*	49	44	52	78,5	15	10	9,5	6	29	35	47	59

* solo disponible en fusibles para semiconductores gS

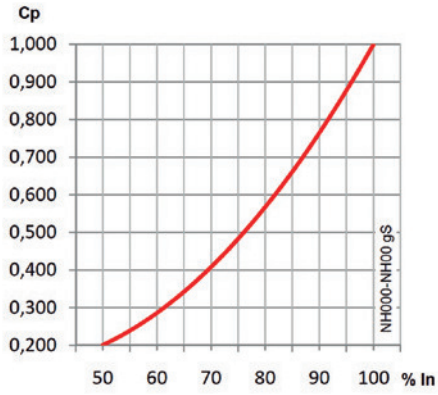
POTENCIAS DISIPADAS

	I_n (A)	I^2t PREARCO (A^2S)	I^2t TOTAL @690V (A^2S)	POTENCIA DISIPADA $0.8 \cdot I_n$ (W)	POTENCIA DISIPADA I_n (W)
NH000	**20**	31	116	2,9	5,1
	25	49	181	3,2	5,6
	32	96	355	3,9	6,6
	40	196	724	4,2	7,2
	50	331	1.224	5,1	8,5
	63	782	2.897	5,3	9,1
	80	1.420	5.270	6,3	11,0
	100	2.130	7.880	7,6	13,3
NH00	**125**	3.380	11.550	8,3	14,7
	160	6.400	21.840	10,5	18,2

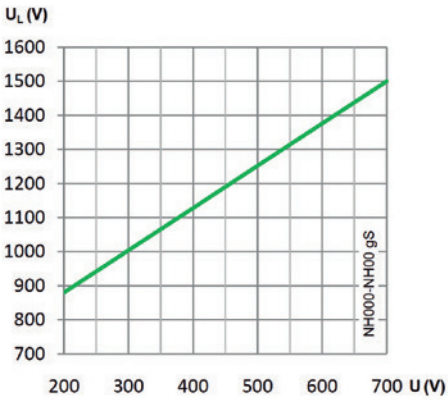
COEFICIENTE DE CORRECCION I^2t (K)



COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



TENSION DE ARCO (U_L)

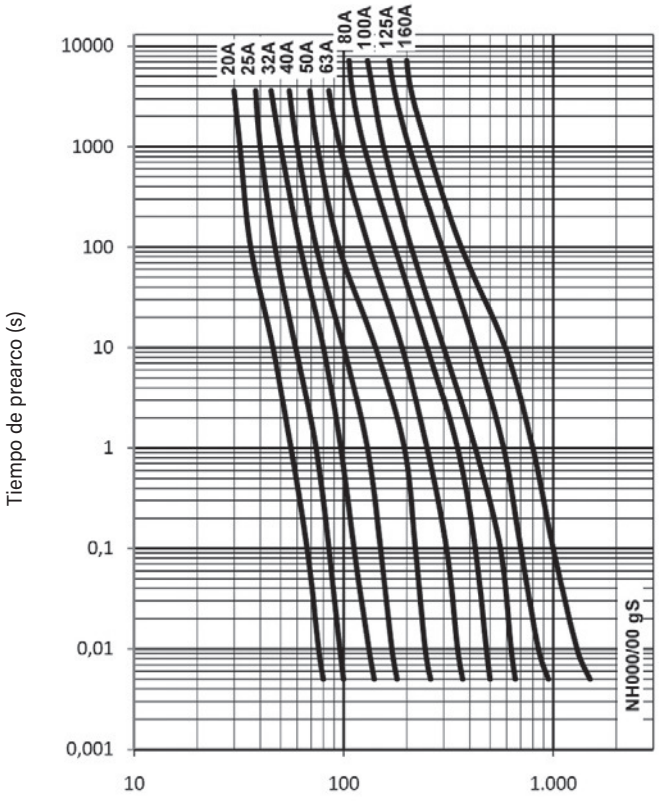


RAPIDPLUS

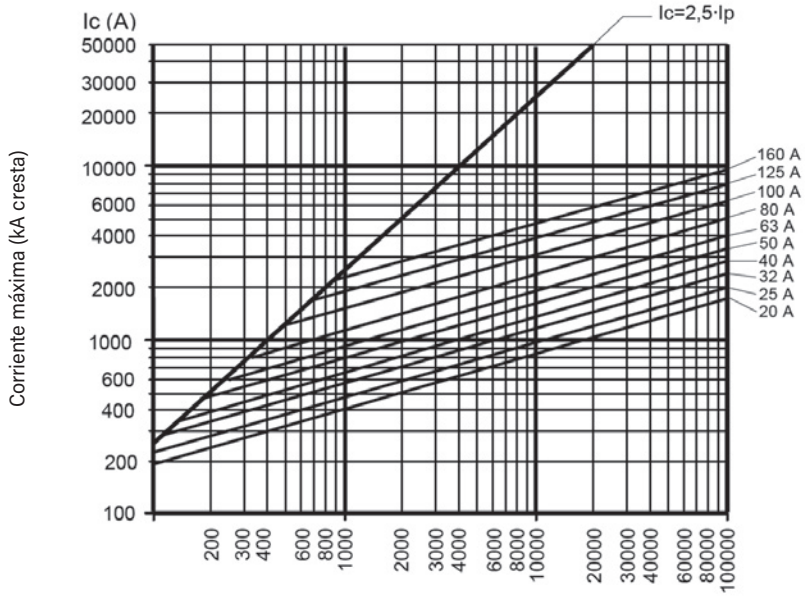
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH000 NH00 gS NH fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

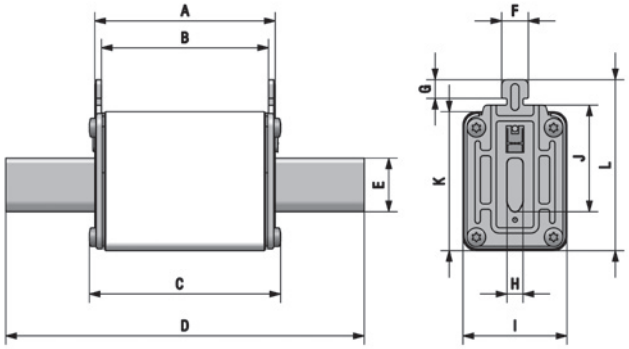
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH1 gS NH fusibles



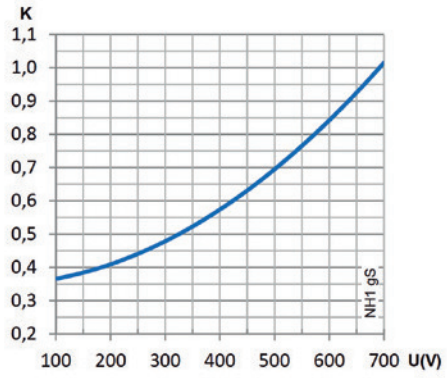
TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	125A...280A	100kA (690V AC)
		30kA (550V DC)

DIMENSIONES

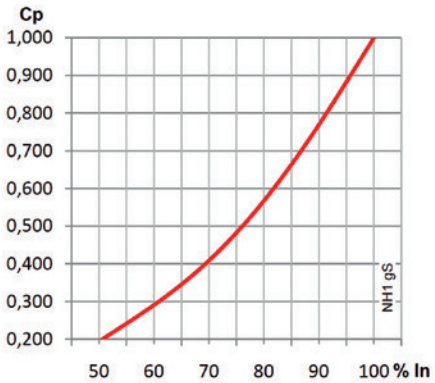


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
68	62	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64

COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



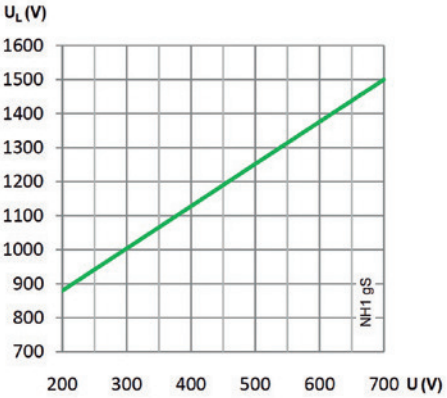
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · I_n	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
125	3.800	11.680	10,7	19,7
160	6.290	19.300	14,5	25,3
200	13.120	40.280	16,1	28,6
250	25.160	77.230	19,5	33,2
280	37.590	115.370	20,1	35,7

TENSION DE ARCO (U_L)

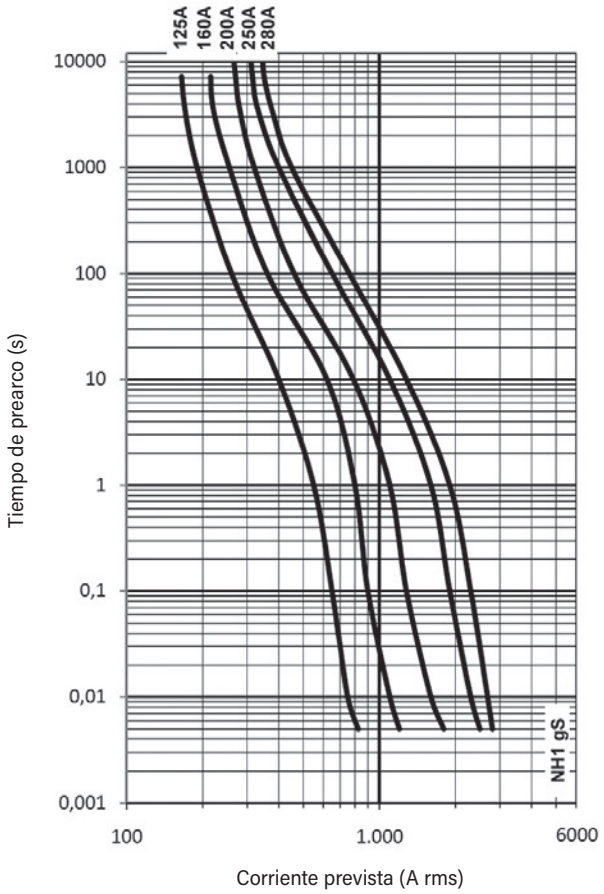


RAPIDPLUS

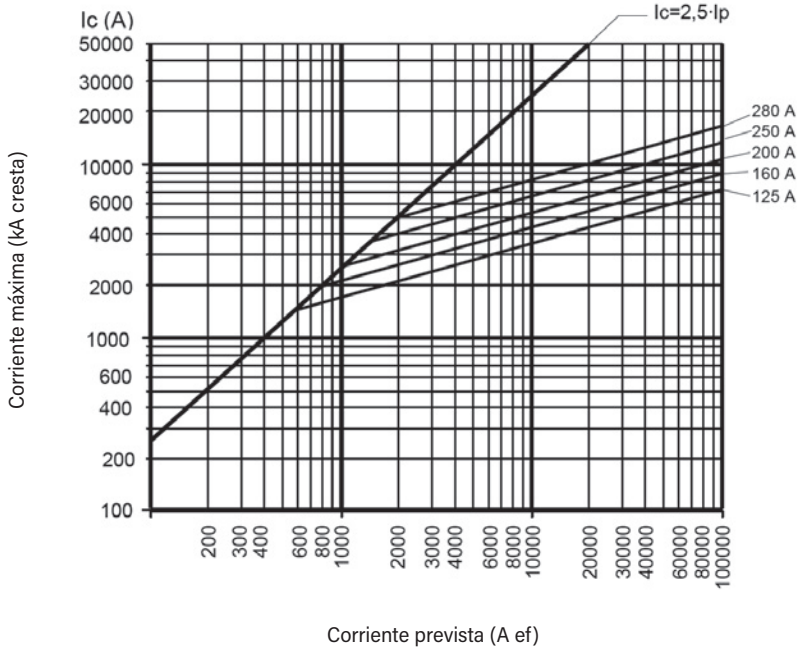
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH1 gS NH fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

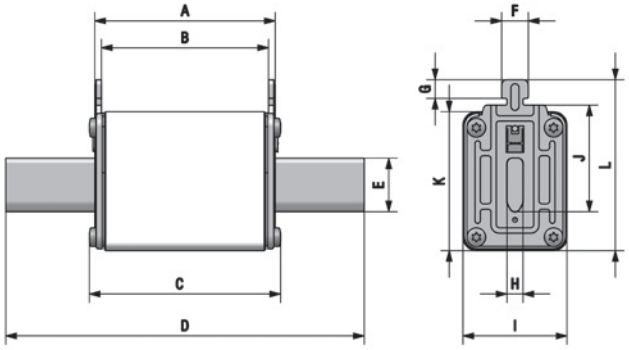
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH2 gS NH fusibles



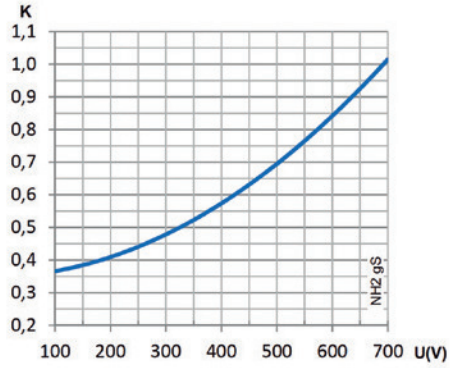
TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	250A...450A	100kA (690V AC)
		30kA (550V DC)

DIMENSIONES

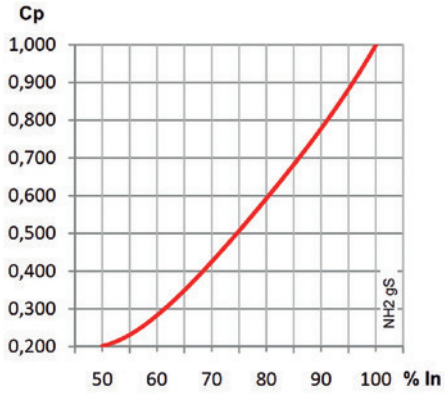


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	48	60	72

COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



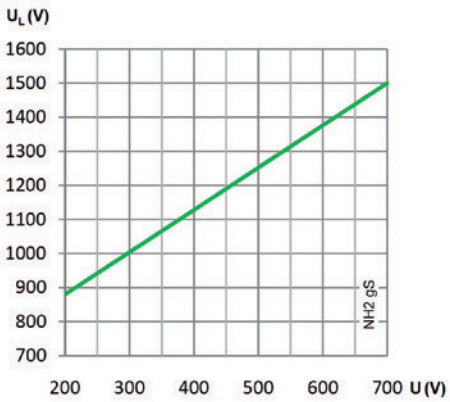
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

In	I²t PREARCO	I²t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · In	POTENCIA DISIPADA In
(A)	(A²S)	(A²S)	(W)	(W)
250	24.280	74.460	18,6	32,2
315	50.660	155.360	20,8	35,8
355	67.450	206.850	23,4	40,1
400	100.770	309.000	24,4	42,6
450	140.740	431.580	33,9	47,2

TENSION DE ARCO (U_L)

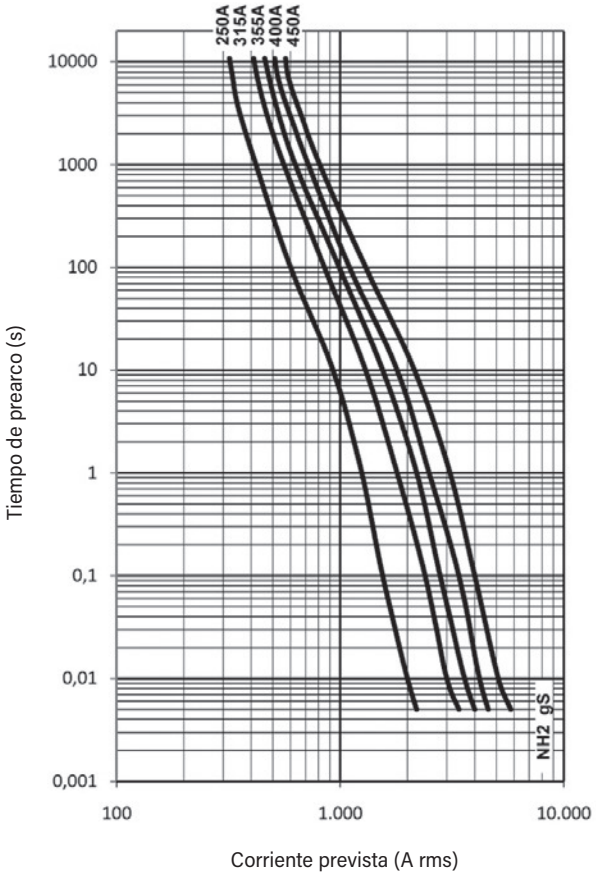


RAPIDPLUS

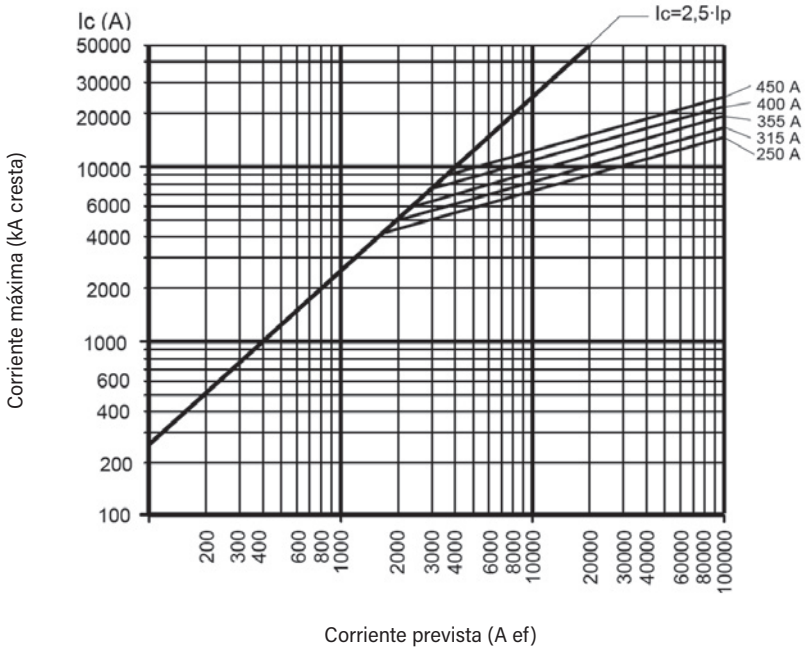
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH2 gS NH fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

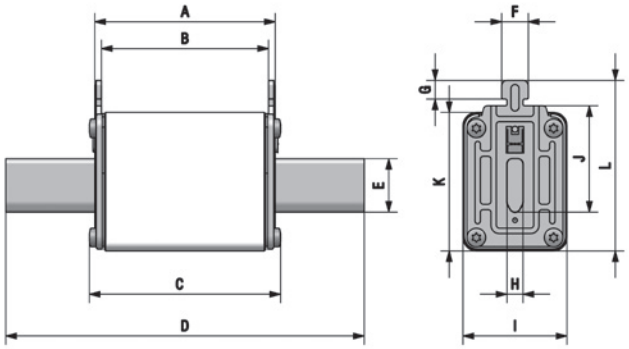
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH3 gS NH fusibles

TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	355A...630A	100kA (690V AC)
		30kA (550V DC)

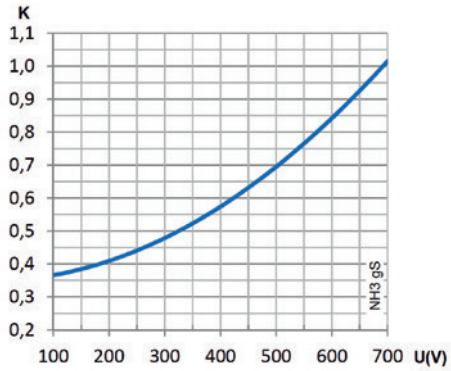


DIMENSIONES

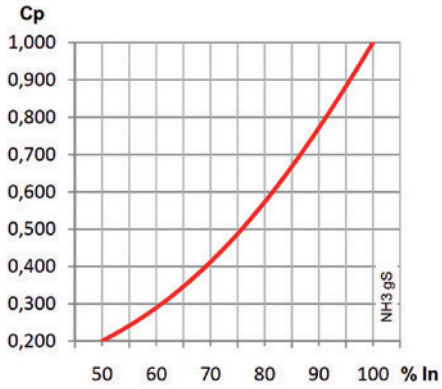


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



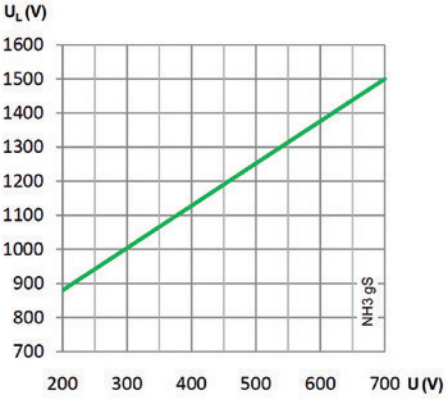
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · I_n	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
355	54.240	151.700	22,7	39,6
400	75.760	211.900	24,3	42,7
450	114.770	320.970	26,3	46,0
500	165.270	462.200	27,6	47,1
630	303.060	847.570	34,3	60,4

TENSION DE ARCO (U_L)

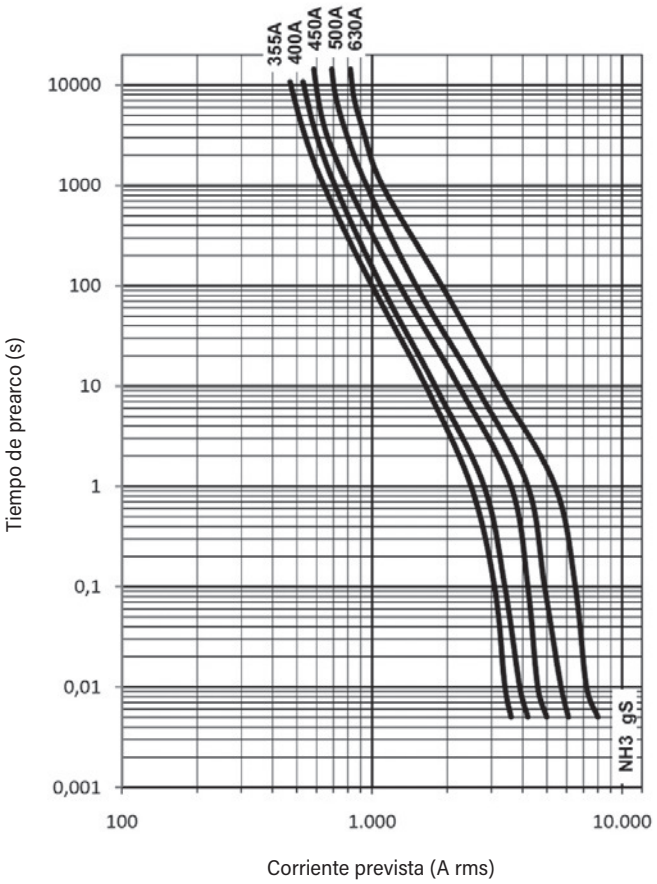


RAPIDPLUS

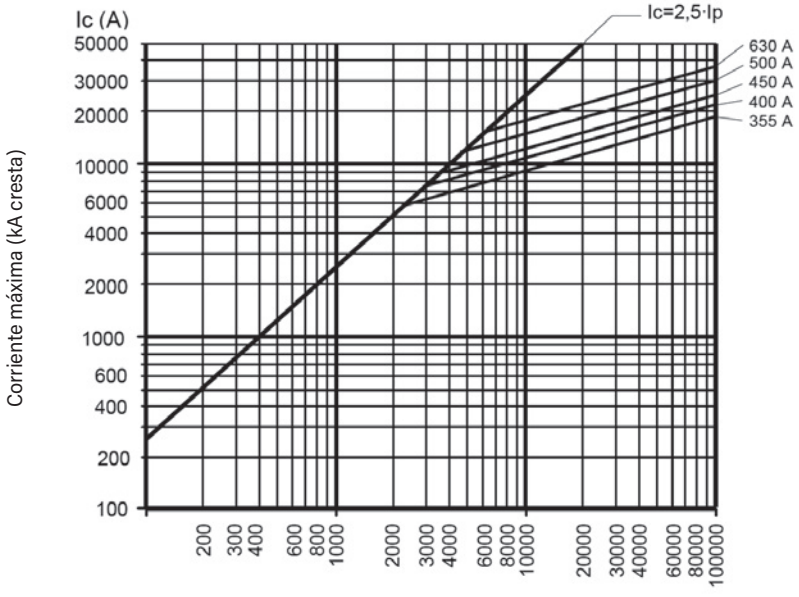
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH3 gS NH fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

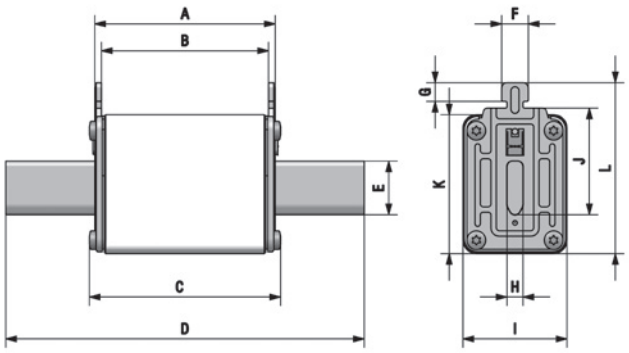
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH000 aR NH fusibles

TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	16A...250A	120kA (690V AC)
		30kA (440V DC)

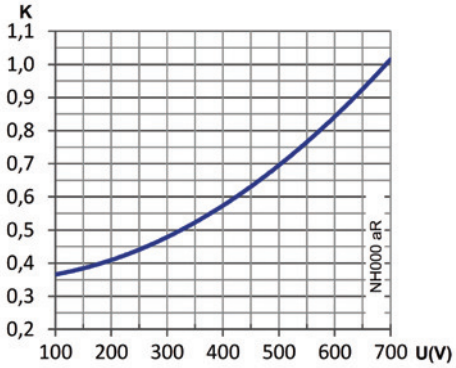


DIMENSIONES

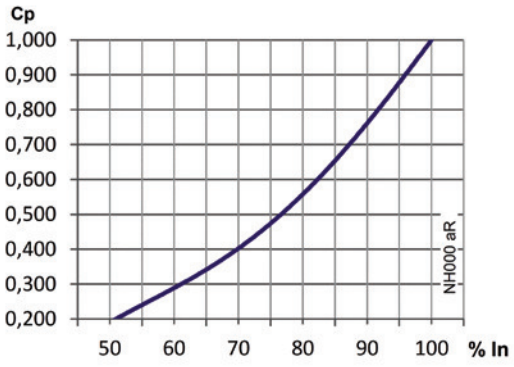


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
49	45	52	78,5	15	10	9,5	6	21	35	40	53

COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



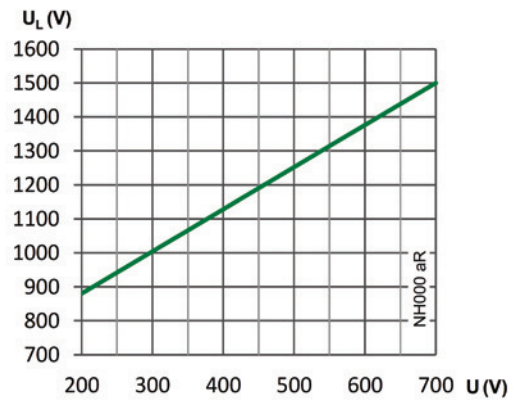
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · I_n	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
16	7	62	2,5	4,5
20	15	121	2,9	5,2
25	24	200	3,8	6,8
32	33	213	4,5	8,0
40	59	379	5,1	9,1
50	157	1.000	5,3	9,5
63	290	2.270	6,9	12
80	550	4.300	8,4	15
100	720	5.880	9,5	17
125	1.410	11.540	11	20
160	2.340	19.080	15	26
200	3.490	28.500	20	36
250	6.500	53.000	26	46

TENSION DE ARCO (U_L)

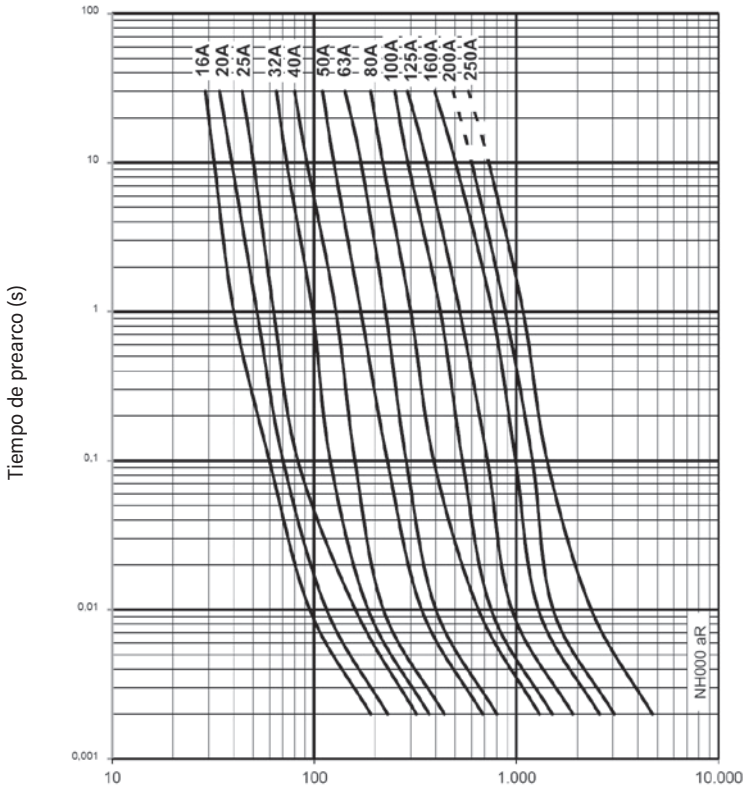


RAPIDPLUS

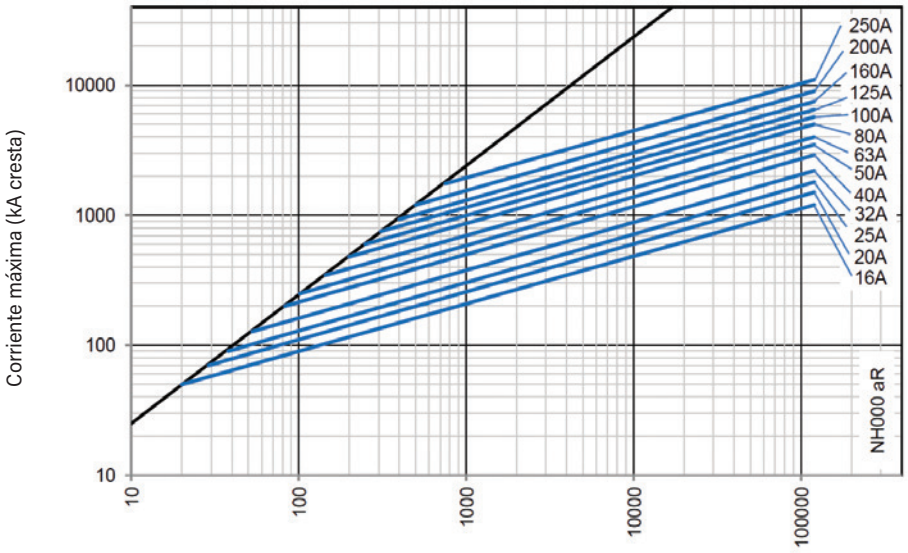
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH000 aR NH fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

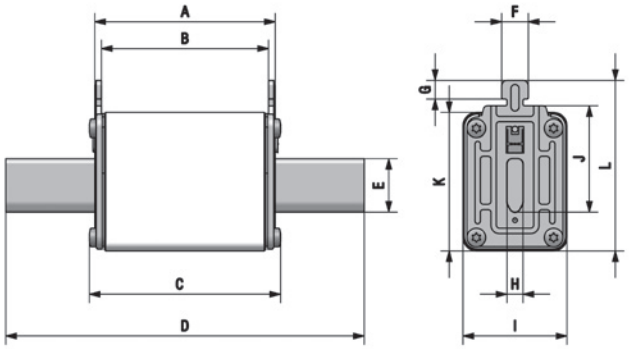
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH1 aR NH fusibles



TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	40A...400A	120kA (690V AC) 30kA (550V DC)

DIMENSIONES

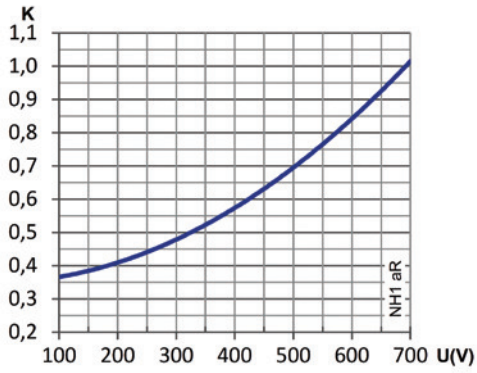


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
68	62	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64

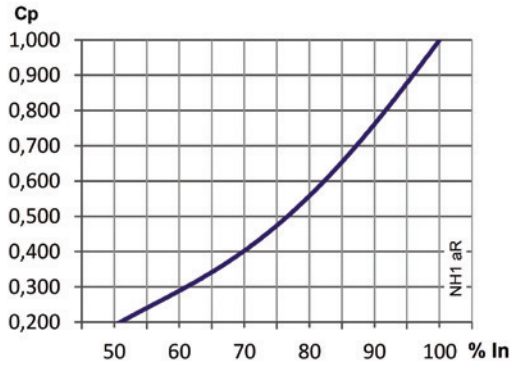
POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · I_n	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
40	55	320	8,1	14
50	97	570	9,6	17
63	220	1.300	11	19
80	370	2.300	13	23
100	570	3.590	18	32
125	980	6.080	24	44
160	1.710	10.560	25	45
200	3.040	18.770	33	59
250	5.400	33.380	41	73
315	10.220	63.110	43	77
350	12.160	75.100	45	80
400	23.000	142.000	52	93

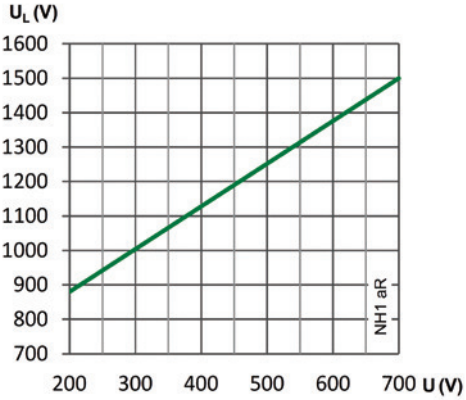
COEFICIENTE DE CORRECCION I^2t (K)



COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



TENSION DE ARCO (U_L)

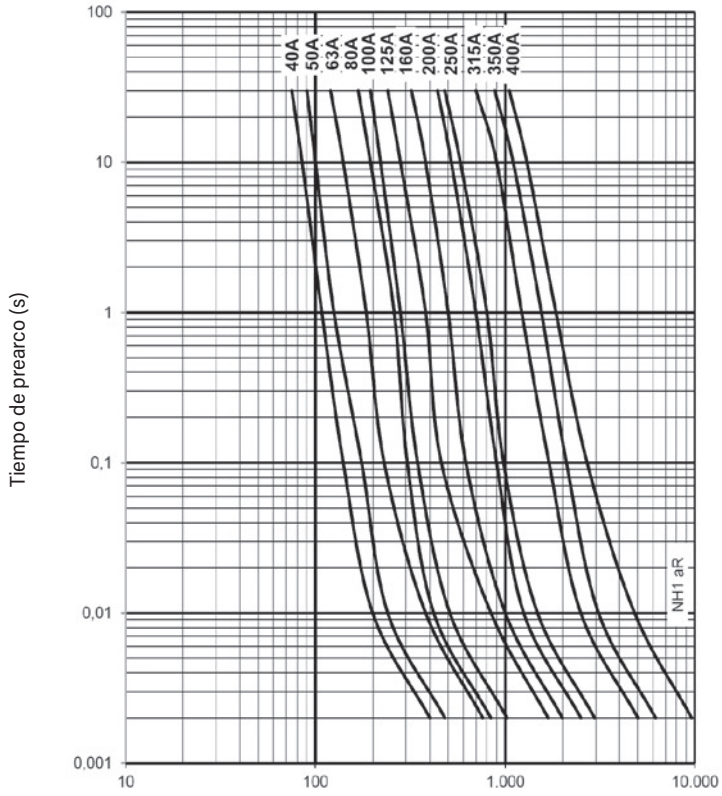


RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

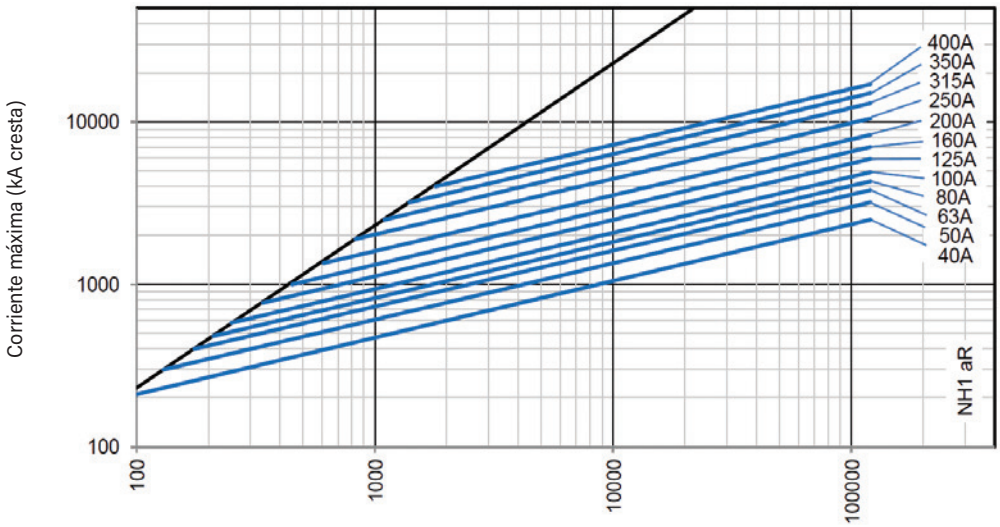
NH NH1 aR NH fusibles

CARACTERISTICAS t-I



Corriente prevista (A rms)

CARACTERISTICAS DE LIMITACION



Corriente prevista (A ef)

RAPIDPLUS

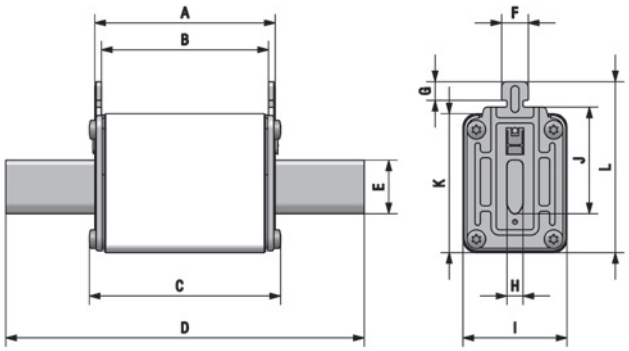
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH2 aR NH fusibles

TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	200A...700A	120kA (690V AC)
		30kA (550V DC)

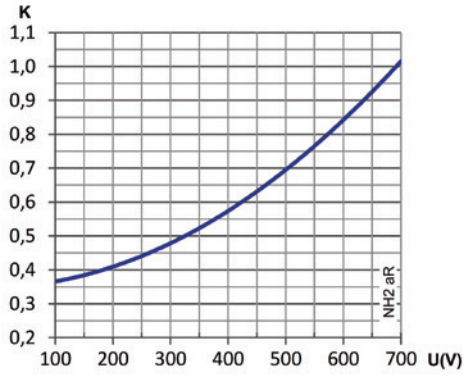


DIMENSIONES

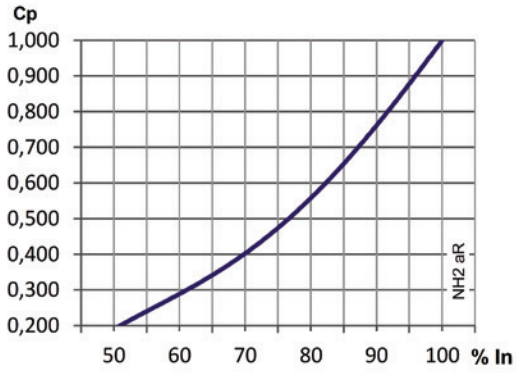


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	48	60	72

COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



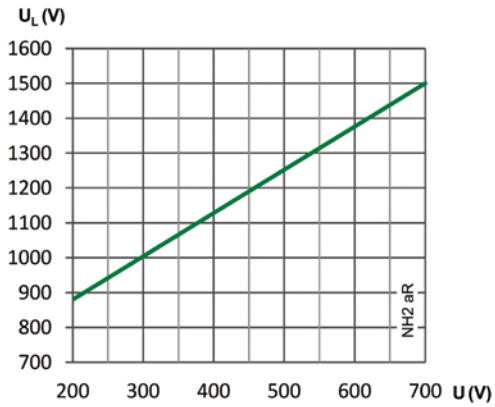
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

In	I²t PREARCO	I²t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · In	POTENCIA DISIPADA In
(A)	(A²S)	(A²S)	(W)	(W)
200	1.550	9.430	53	95
250	3.250	19.670	56	100
315	6.230	37.720	57	102
350	9.300	56.340	58	104
400	13.000	78.700	72	129
450	17.000	102.000	77	137
500	24.500	147.000	83	148
550	36.000	216.000	85	152
630	47.220	283.330	95	170
700	68.000	408.000	99	178

TENSION DE ARCO (U_L)

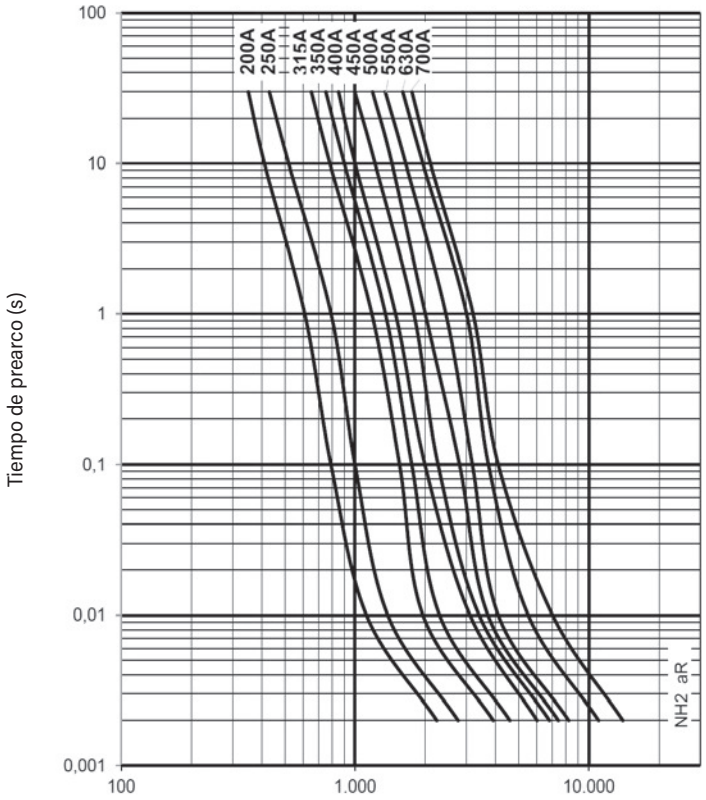


RAPIDPLUS

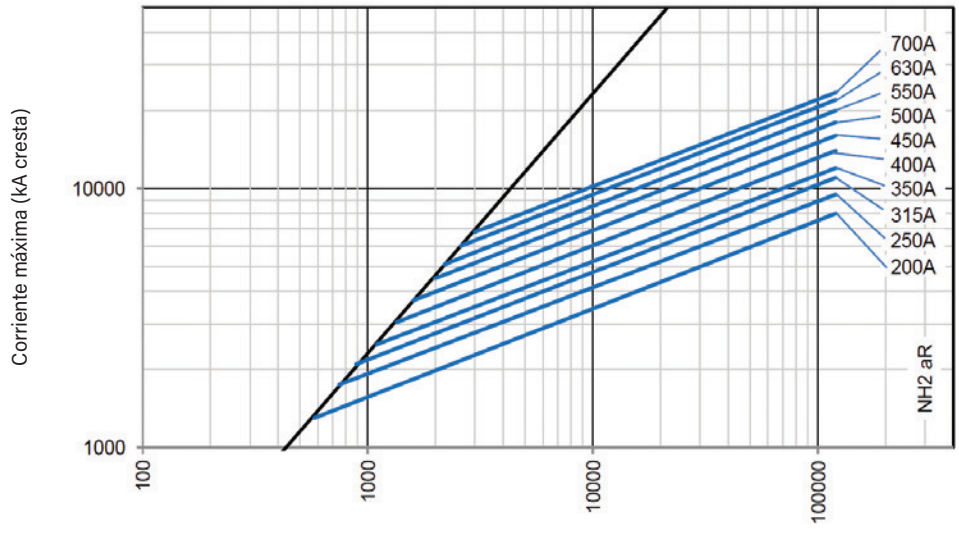
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH2 aR NH fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

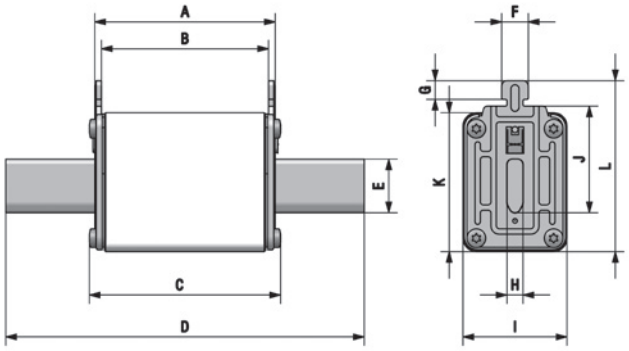
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH3 aR NH fusibles

TENSION ASIGNADA	CORRIENTE ASIGNADA	PODER DE CORTE
690V AC	500A...1000A	120kA (690V AC)
		30kA (550V DC)

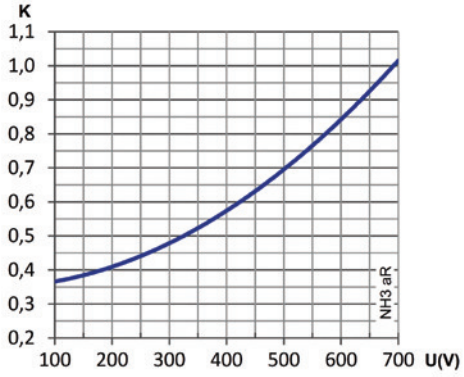


DIMENSIONES

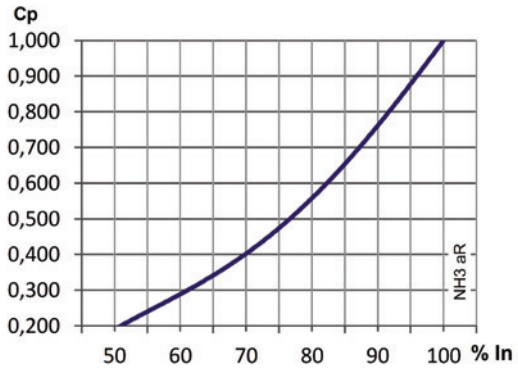


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

COEFICIENTE DE CORRECCION I²t (K)



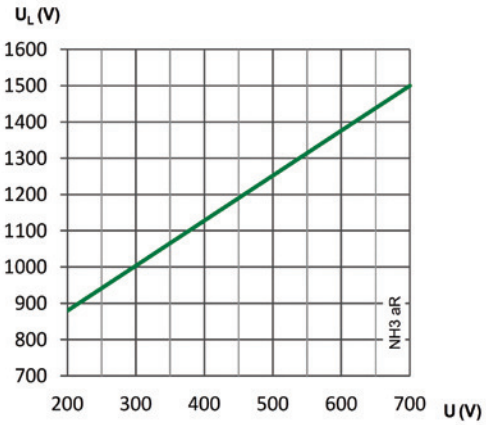
COEFICIENTE DE CORRECCION POTENCIA DISIPADA (Cp)



POTENCIAS DISIPADAS

I_n	I^2t PREARCO	I^2t TOTAL @690V	POTENCIA DISIPADA 0.8 · I_n	POTENCIA DISIPADA I_n
(A)	(A^2S)	(A^2S)	(W)	(W)
500	22.160	109.000	76	136
550	32.100	158.060	81	145
630	45.500	220.000	89	159
700	65.520	322.200	103	184
800	97.870	481.310	107	191
900	126.380	621.520	121	216
1000	182.000	895.000	150	268

TENSION DE ARCO (U_L)

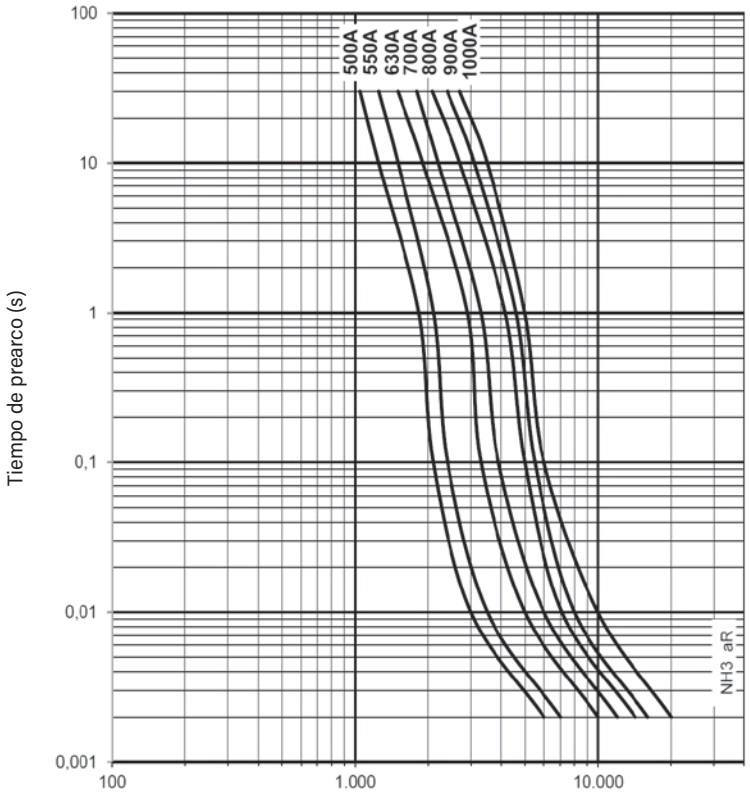


RAPIDPLUS

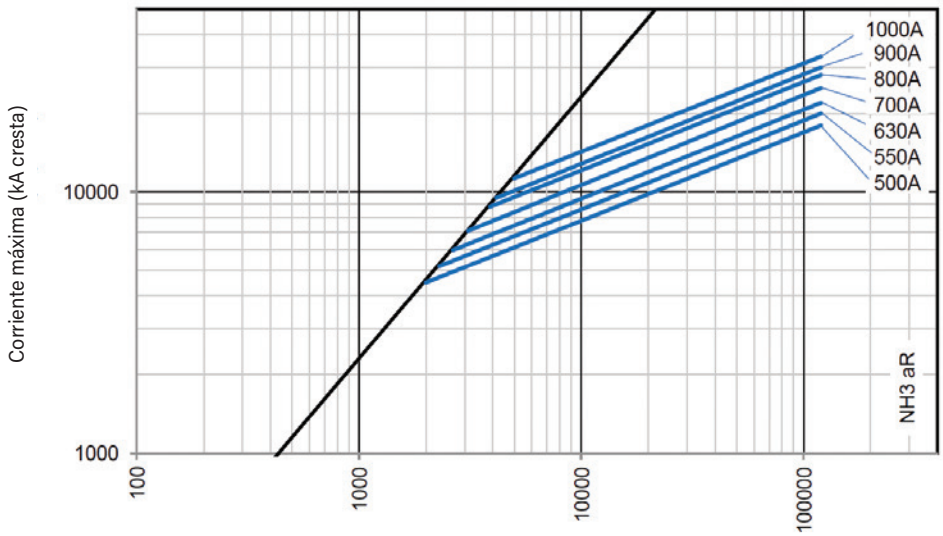
FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH NH3 aR NH fusibles

CARACTERISTICAS t-I



CARACTERISTICAS DE LIMITACION



RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

CYL | aR | gR CILINDRICOS fusibles



USO DE FUSIBLES RAPIDPLUS EN PORTAFUSIBLES MODULARES PMX

Las bases modulares para fusibles cilíndricos tienen unos niveles de potencia disipable que están en concordancia con las máximas potencias que los fusibles de uso general (gG) o de acompañamiento (aM) pueden alcanzar.

Estos valores máximos para los fusibles gG/aM están regulados por normas (IEC/EN60269-2). Asimismo la norma también regula la potencia disipable mínima para las bases, entendiéndose como potencia disipable aquella potencia generada en el fusible (y que se convierte en calor) que la base es capaz de disipar, es decir, que no provoca en la base unos calentamientos superiores a los admisibles.

Los fusibles ultrarrápidos o de protección de semiconductores tienen potencias disipadas superiores a las de los fusibles gG y aM; por ello existen limitaciones en cuanto a la aplicación de estos fusibles en bases modulares cerradas. Deberemos verificar que los fusibles que queremos instalar tienen una potencia disipada menor o igual al máximo valor disipable por la base indicado por el fabricante.

A continuación se indican los valores límite para las bases DF ELECTRIC que no deben ser sobrepasados bajo ningún concepto:

PMX | PMX CILINDRICOS portafusibles

	10x38	14x51	22x58
POTENCIA DISIPADA MÍNIMA **IEC/EN60269-2**	3W	5W	9,5W
POTENCIA DISIPABLE MÁXIMA **PORTAFUSIBLES DF ELECTRIC**	4W	6W	12W



RAPIDPLUS

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA SEMICONDUCTORES

NH aR NH fusibles



COEFICIENTE DE CORRECCION C_L

Debido a los altos valores de potencia disipada de los fusibles NH aR, es necesario aplicar un coeficiente de reducción que determina la máxima corriente admisible cuando estos fusibles se instalan en una base NH o en un seccionador.

$$I_{MAX.} = I_N \times C_L$$

	I_n	BASES NH ABIERTAS	SECCIONADORES NH
	(A)		
NH000	**16**	1	1
	20	1	1
	25	1	1
	32	1	1
	40	1	1
	50	1	1
	63	1	1
	80	1	0.95
	100	1	0,90
	125	0,95	0,85
	160	0,90	0,75
	200	0,80	0,70
	250	0,80	0,60

	I_n	BASES NH ABIERTAS	SECCIONADORES NH
	(A)		
NH1	**40**	1	0.95
	50	0,90	0,85
	63	0,90	0,85
	80	0,90	0,85
	100	0,90	0,85
	125	0,75	0,70
	160	0,75	0,70
	200	0,75	0,70
	250	0,75	0,70
	315	0,75	0,65
	350	0,70	0,65
	400	0,70	0,60

	I_n	BASES NH ABIERTAS	SECCIONADORES NH
	(A)		
NH2	**200**	0,70	0,65
	250	0,70	0,65
	315	0,70	0,65
	350	0,70	0,65
	400	0,70	0,65
	450	0,65	0,60
	500	0,65	0,60
	550	0,65	0,60
	630	0,65	0,55
	700	0,65	0,55

	I_n	BASES NH ABIERTAS	SECCIONADORES NH
NH3	**500**	0,70	0,65
	550	0,70	0,65
	630	0,70	0,65
	700	0,70	0,60
	800	0,70	0,60
	900	0,65	0,55
	1000	0,60	0,50